

車載MOSFET L-TOGL™シリーズ

L-TOGL™ family for Automotive MOSFETs

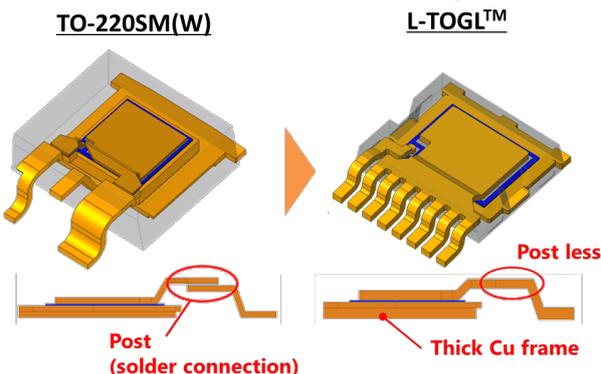
大電流アプリに最適な低損失プロセス・高放熱パッケージ

Point

1

低損失プロセスおよび高放熱パッケージ構造を採用

- はんだ接続のないポストレス構造および厚銅フレームの採用により、低パッケージ抵抗と高放熱特性を実現。

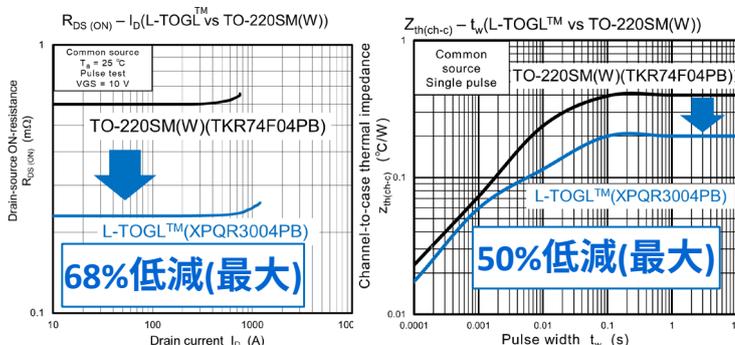


Point

2

オン抵抗と熱抵抗を低減

- 従来パッケージであるTO-220SM(W)に比べ大幅な性能アップを実現し、低損失化に貢献します。

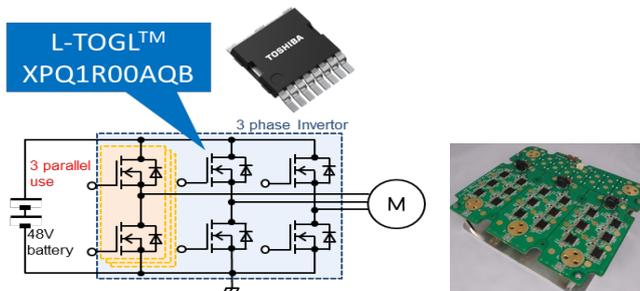


Point

3

小型Battery-EV向け走行インバータシステムに採用検討実績あり

- 多様な進化を遂げているBattery-EVにおいて、48Vバッテリー走行インバータを中心に採用検討実績あり。
- 低損失と優れた放熱性でセットの小型化、高出力化に貢献。



展示品等価回路概要
(インバータ回路)

株式会社デンソーテン様
試作採用事例

※「L-TOGL™」は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。